



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: KAIJU, Hideo, et al.

Group Art Unit: Not Yet Assigned

Serial No.: 10/827,367

Examiner: Not Yet Assigned

Filed: April 20, 2004

PTO Confirmation No.: 3830

For: **MAGNETIC SENSOR UTILIZING MAGNETORESISTANCE EFFECT, METHOD FOR DRIVING MAGNETIC SENSOR UTILIZING MAGNETORESISTANCE EFFECT AND MAGNETIC RECORDING SYSTEMS (AS AMENDED)**

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Date: August 12, 2004

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior foreign application is hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Appln. No. 2003-118197, filed April 23, 2003

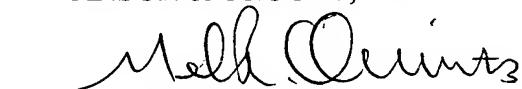
In support of this claim, the requisite certified copy of said original foreign application is filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copy.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,

ARMSTRONG, KRATZ, QUINTOS,
HANSON & BROOKS, LLP


Mel R. Quintos

Attorney for Applicants

Reg. No. 31,898

MRQ/lrj
Atty. Docket No. **040163**
Suite 1000
1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
(202) 659-2930



23850

PATENT TRADEMARK OFFICE

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 4月23日

出願番号
Application Number: 特願2003-118197

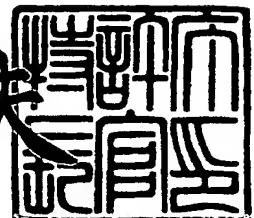
[ST. 10/C] : [JP 2003-118197]

出願人
Applicant(s): 学校法人慶應義塾

2004年 4月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



CERTIFIED COPY OF
PRIORITY DOCUMENT

BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3031363

【書類名】 特許願
【整理番号】 000000452
【提出日】 平成15年 4月23日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 G11B 5/39
G11B 5/02
【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 慶應義塾大学
理工学部内

【氏名】 海住 英生

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1 慶應義塾大学
理工学部内

【氏名】 椎木 一夫

【特許出願人】

【識別番号】 899000079

【氏名又は名称】 学校法人慶應義塾

【代理人】

【識別番号】 100105337

【弁理士】

【氏名又は名称】 真鍋 潔

【選任した代理人】

【識別番号】 100072833

【弁理士】

【氏名又は名称】 柏谷 昭司

【選任した代理人】

【識別番号】 100075890

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡邊 弘一

【選任した代理人】

【識別番号】 100110238

【弁理士】

【氏名又は名称】 伊藤 壽郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 075097

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 磁気抵抗効果を用いた磁気センサ、磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法、及び、磁気記録装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 トランジスタ及びLC回路からなる発振回路の前記トランジスタとLC回路との帰還ループの一部に磁気抵抗効果素子を接続するとともに、スイッチング手段を設けたことを特徴とする磁気抵抗効果を用いた磁気センサ。

【請求項2】 上記発振回路が、ハートレー型発振回路或いはコルピツ型発振回路のいずれかであることを特徴とする請求項1記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサ。

【請求項3】 上記磁気抵抗効果素子が、トンネル磁気抵抗効果素子であることを特徴とする請求項1または2に記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサ。

【請求項4】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法において、上記スイッチング手段のスイッチング周波数によって磁気データの読み取り速度を規定することを特徴とする磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法。

【請求項5】 請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサを再生用磁気ヘッドとして備えたことを特徴とする磁気記録装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は磁気抵抗効果を用いた磁気センサ、磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法、及び、磁気記録装置に関するものであり、特に、従来より高感度で磁気情報を検出するための回路構成に特徴のある磁気抵抗効果を用いた磁気センサ、磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法、及び、磁気記録装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】

近年、高密度磁気記録装置における再生用磁気ヘッドとして、巨大磁気抵抗（GMR：Giant Magneto Resistive）効果を利用した磁気ヘッドが用いられている。

【0003】

この様な磁気ヘッドにおける磁気センシング方法においては、磁化方向が固定された磁性層（ピンド層）と磁化方向が自由な磁性層（フリー層）との間に非磁性導電層を設けたGMR素子に一定のセンス電流を流し、高密度に磁気記録信号が書き込まれた磁気記録媒体から漏洩する磁束の変化に対応してGMR素子の電位差が変化する現象を利用している。

したがって、大電流を流せばオームの法則により大きな出力が得られるが、発熱等により実際に流せるセンス電流には限界がある。

【0004】

近年、このようなGMR素子に代わる次世代の再生用磁気ヘッドとしてスピントンネル磁気抵抗（TMR：Tunneling Magneto Resistive）効果を用いた磁気ヘッドの研究が進められている（例えば、特許文献1参照）。

【0005】

このTMR素子は、磁化方向の固定された磁性層（ピンド層）と磁化方向が自由な磁性層（フリー層）との間にAl—oxide等の絶縁層を挟んだ構造となっており、センス電流を磁気感知膜面に垂直に流した場合に、2つの磁性層の磁化方向のなす角により絶縁膜を通過するトンネル電流が変化し、その変化をTMR素子の電位差の変化として読み取るものである。

【0006】

このTMR素子は、例えば、数十%程度の非常に大きな抵抗変化率が得られるため、大きな出力が期待される。

【0007】

しかし、TMR素子はAl—oxide等の絶縁膜を挟んでいるため抵抗値が非常に大きく実際には大きなセンス電流を流すことができず、したがって、大きな出力が得られないという問題がある。

【0008】

また、抵抗が大きいため、ノイズが大きいという欠点があり、TMR素子の出力を増幅した場合には出力は大きくなるもののノイズも大きく増幅され、微弱な磁束の検出を高精度で行うことができなくなる。

【0009】

一方、検出感度の低いMR素子においては、MR素子をハートレー型発振回路或いはコルピツ型発振回路に組み込むことにより、MR素子の抵抗変化をリアクタンス変化に変換し、それによって、高周波信号の有無を検出することが提案されている（例えば、特許文献2参照）。

【0010】**【特許文献1】**

特開2002-237628号公報

【特許文献2】

特開平06-338005号公報

【0011】**【発明が解決しようとする課題】**

しかし、上記の特許文献2の場合には、MR素子がLC回路の一部を構成、即ち、MR素子が発振回路の共振部を構成しているため、MR素子の抵抗が変化すると発振が不安定になるという問題がある。

【0012】

そのため、画像データを記録するビデオテープ記録装置のように $10^{-4} \sim 10^{-5}$ 程度のエラーが許容される場合には実際上問題が生じなくても、ハードディスク装置のように 10^{-7} 程度以下のエラーレートが要求されるセンシング法としては向いていないという問題がある。

【0013】

また、MR素子が共振回路を構成しているため、MR素子に大きな電流が流れ、それによって、素子特性が変化したり破壊する虞がある。

特に、絶縁層を有し絶縁破壊が問題となるTMR素子の場合は、上述の回路構成は実用的でない。

【0014】

したがって、本発明は、流し得るセンス電流の上限による高感度化の制約を打破することを目的とする。

【0015】**【課題を解決するための手段】**

図1は本発明の原理的構成の説明図であり、この図1を参照して本発明における課題を解決するための手段を説明する。

図1参照

(1) 本発明は、磁気抵抗効果を用いた磁気センサにおいて、トランジスタ2及びLC回路3からなる発振回路1のトランジスタ2とLC回路3の帰還ループの一部に磁気抵抗効果素子4を接続するとともに、スイッチング手段5を設けたことを特徴とする。

【0016】

この様に、発振回路1を構成するトランジスタ2とLC回路3の帰還ループの一部に磁気抵抗効果素子4を接続することによって、従来の数十倍の高出力で磁気信号を検出することが可能になる。

また、スイッチング手段5を設けることによって、一度始まった発振の停止を制御することができる。

【0017】

(2) また、本発明は、上記(1)において、発振回路1が、ハートレー型発振回路或いはコルピツ型発振回路のいずれかであることを特徴とする。

【0018】

この様に、ハートレー型発振回路或いはコルピツ型発振回路という良く知られている発振回路を用いることによって、簡単な回路構成によって安定した発振動作を得ることができる。

即ち、MHz以上の高周波帯域において磁気信号を検出するために、高周波発振が可能なハートレー型発振回路或いはコルピツ型発振回路が適しているためである。

【0019】

(3) また、本発明は、上記(1)または(2)において、磁気抵抗効果素子4が、トンネル磁気抵抗効果素子であることを特徴とする。

【0020】

磁気信号を検出する磁気抵抗効果素子4としては、相対的に大きな磁気抵抗効果が得られる、トンネル磁気抵抗効果素子(TMR素子)或いはスピンドルブ型巨大磁気抵抗効果素子(GMR素子)のいずれかが好適である。

特に、高周波数の磁気信号を検出する場合には、磁気抵抗効果素子4としては、トンネル磁気抵抗効果素子(TMR素子)のように容量性の素子である場合に特に効果が著しい。

【0021】

(4) また、本発明は、上記(1)乃至(3)のいずれかに記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法において、スイッチング手段5のスイッチング周波数によって磁気データの読み取り速度を規定することを特徴とする。

【0022】

この様に、磁気データの読み取り速度は発振の停止を制御するスイッチング手段5のスイッチング周波数によって規定されるので、スイッチング手段5のスイッチング周波数を高くすることによって、高速読み出しが可能になる。

但し、発振回路1の発振周波数はスイッチング周波数に応じて変える必要があり、発振周波数は、スイッチング周波数の10倍以上とすることが望ましい。

【0023】

(5) また、本発明は、磁気記録装置において、上記(1)乃至(3)のいずれかに記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサを再生用磁気ヘッドとして備えたことを特徴とする。

【0024】

この様に、上記(1)乃至(3)のいずれかに記載の磁気抵抗効果を用いた磁気センサを再生用磁気ヘッドとして備えることによって、微細化により漏洩磁界が微弱になる高密度磁気記録装置の実現が可能になる。

【0025】

また、高感度になることにより、単純に増幅器を用いた場合に比べてS/N比

を大きくすることができ、したがって、磁気抵抗効果素子4の特性のばらつきの影響を受けにくくなるので、素子特性の再現性に乏しいTMR素子の製造歩留りの向上が可能になる。

【0026】

【発明の実施の形態】

ここで、図2及び図3を参照して本発明の第1の実施の形態の高感度磁気検知方法を説明する。

図2参照

図2は、本発明の第1の実施の形態の高感度磁気検知装置の回路構成図であり、ハートレー型発振回路10とRFスイッチング回路30とから構成される。

【0027】

ハートレー型発振回路10を構成する直列接続したインダクタ13とインダクタ14とコンデンサ15との並列接続からなるLC共振回路と、トランジスタ16のドレインとの間に、RFスイッチング回路30及び抵抗器18を介してTMR素子20を直列接続する。

【0028】

この場合、TMR素子20に流れる直流電流及び交流電流を小さくし素子の破壊及び特性変化を防ぐために、TMR素子20に直列に抵抗器21を接続するとともに、並列にコンデンサ22を接続し、TMR素子20の一端を抵抗器12及びインダクタ11を介して電源V_{DD}に接続する。

【0029】

この場合のTMR素子20としては、どの様なものでも良いが、ここでは、FeCoピンド層/Al-oxide/NiFeフリー層からなるTMR素子とし、FeCoとNiFeの保磁力の差を利用してFeCoピンド層の磁化方向を初期の外部磁場の印加方向に固定する。

【0030】

また、LC共振回路の他端は、コンデンサ17を介してトランジスタ16のゲートに接続されるとともに、ダイオード19を介して接地される。

【0031】

また、RFスイッチング回路30は、高周波用トランジスタ31を備え、パルス発生器32からのパルス入力V_{IN}は、コンデンサ33及び抵抗器35からなる微分回路、ダイオード34及び抵抗器36からなる半波整流回路を介して高周波用トランジスタ31のゲートに入力されて高周波用トランジスタ31のスイッチング動作を制御する。

【0032】

このRFスイッチング回路30をONにした状態で、TMR素子20のインピーダンスが外部磁場の影響でハートレー型発振回路10の発振条件を満たすようにならぬ場合、直列接続したインダクタ13とインダクタ14とコンデンサ15との並列接続からなるLC共振回路により発振が始まり、発振信号V_{OSC}は、トランスを構成するインダクタ23を介して検波器とローパスフィルタとからなる直流変換回路24へ入力され、端子25から出力されることになる。

【0033】

しかし、TMR素子20のインピーダンス変化によって一度発振が開始すると、TMR素子20のインピーダンスが元に戻っても発振が停止しないため、RFスイッチング回路30をOFFにして発振を停止する。

【0034】

RFスイッチング回路30をOFFにするためには、RFスイッチング回路30に印加するパルス入力V_{IN}の立ち下がり部を利用するものであり、パルス入力V_{IN}の周波数に応じてスイッチするON/OFFのウインドウを作る。

例えば、250MHzのパルス入力V_{IN}によってON時間約3.9nsのウインドウ内に生じるTMR素子20のインピーダンス変化を検出し、OFF時間約0.1nsで発振をリセットする。

【0035】

このハートレー型発振回路10において、インダクタ13、14のインダクタンスを各々0.1nHとし、コンデンサ15の容量を0.1pFとした結果、17.2GHzの発振周波数で発振する。

【0036】

また、高速磁気検知においては、発振立ち上がり時間を短くする必要があるの

で、トランジスタ16として室温動作可能で増幅率の大きな高周波用のInGaAsFET等を用いることにより、0.1ns程度の極短の発振動作立ち上がり時間を実現することができる。

【0037】

また、上述のTMR素子20に流れる直流電流及び交流電流を小さくするために接続した抵抗器21の抵抗値は例えば、1.3kΩとし、コンデンサ22の容量は50pFとすることによりTMR素子20に流れる電流を約1.7mAに抑えることができる。

なお、この抵抗値及び容量は発振条件にはほとんど影響しない。

【0038】

また、電源V_{DD}、インダクタンス11、及び、抵抗器12を、各々15V、1mH、及び、100Ωとすることによって、ピーク-ピーク発振電圧としてV_{osc}_c=5V_{pp}以上の出力を得ることができる。

なお、コンデンサ17の容量は1pFであり、また、抵抗器18の抵抗値は4Ωとする。

【0039】

次に、図3を参照して、発振出力の検出結果を説明する。

図3（a）乃至（c）参照

図3（a）は、TMR素子20の抵抗値R_Tの変化を説明するタイムチャートであり、t=1.5nsにおいて、外部磁場により抵抗値R_Tが110Ωから100Ωへと変化したことを示している。

また、図3（b）は、パルス発生器33からのパルス入力V_{IN}の電圧波形であり、250MHzのパルス電圧として示しており、このパルスの立ち下がりによってスイッチング回路がOFFとなる。

【0040】

また、図3（c）は、発振検出出力V_{osc}の波形図であり、t=0nsでRFスイッチング回路30がONして、待機状態とし、図3（a）に示すように、t=1.5nsにおいてTMR素子20の抵抗値R_Tが変化したことを検出して、トランジスタ16の特性に応じて約0.1nsの発振動作立ち上がり時間で発振

が開始する。

【0041】

次いで、 $t = 0$ から 3.9 n s の ON 時間ののち、パルス入力 V_{IN} の立ち下がりと共に約 0.1 n s の OFF 時間で発振をリセットさせた場合、 $t = 4.0 \text{ n s}$ において RF スイッチング回路 30 が OFF になって、 0.15 n s の発振停止遅延時間で発振が停止する。

【0042】

この場合の発振電圧 V_{osc} は、ピーク-ピーク電圧で 8.3 V_{pp} となり、従来の TMR 素子の検出出力の数十倍の高出力が得られる。

【0043】

即ち、本発明の第 1 の実施の形態においては、外部磁場の印加によりインピーダンス変化が生ずる TMR 素子 20 をハートレー型発振回路 10 の帰還ループ内に組み込んでおり、発振周波数は主としてインダクタ 13, 14 及びコンデンサ 15 等によって決まり安定しているので、 10^{-7} 以下のエラーレートを容易に実現することができる。

【0044】

しかし、安定して発振するため、素子抵抗が元に戻っても発振は停止しないため、発振を制御する RF スイッチング回路 30 と組み合わせることによって、ある時間内に磁場変化が生じたか否かの信号の有無を高感度で検出することが可能になる。

【0045】

また、帰還ループの TMR 素子 20 に直列に抵抗 21 及び並列に 22 等を挿入することによって、TMR 素子 20 に流れる電流を低減することができるので、TMR 素子 20 が破壊されることはない。

【0046】

この様に、本発明の第 1 の実施の形態の高感度磁気検知装置の場合には、従来に比べて非常に高感度で大出力が得られるため、TMR 素子の素子特性にバラツキがあっても「0」、「1」信号を安定に検出することができるので、TMR 素子の良品率を高くすることができ、結果として製造歩留りを向上することができ

る。

【0047】

即ち、TMR素子においては、Alを酸化してAl-oxideからなるトンネル絶縁膜を形成する際に、再現性良く均一なトンネル絶縁膜を形成することが困難であるため、素子特性のバラツキが大きくなるが、本発明によって、従来、不良品として扱われていた素子も良品として使用することが可能になる。

【0048】

次に、図4を参照して、本発明の第2の実施の形態の高感度磁気検知回路を説明するが、上記の第1の実施の形態の高感度磁気検知回路におけるハートレー型発振回路をコルピツ型発振回路に置き換えたものであり、基本的構成は同様であるので、詳細な説明は省略する。

【0049】

図4参照

図4は、本発明の第2の実施の形態の高感度磁気検知装置の回路構成図であり、ハートレー型発振回路10を構成する直列接続したインダクタ13とインダクタ14とコンデンサ15との並列接続からなるLC共振回路を、直列接続したコンデンサ42とコンデンサ43とインダクタ41との並列接続からなるLC共振回路に置き換えることによって、コルピツ型発振回路40を構成したものである。

【0050】

この場合、発振信号V_{OSC}は、LC共振回路を構成するコンデンサ42を介して検波器とローパスフィルタとからなる直流変換回路24へ入力され、端子25から出力されることになる。

【0051】

この第2の実施の形態においては、発振回路としてコルピツ型発振回路を用いているので、ハートレー型発振回路に比べてインダクタの構成が容易で、LSI等に向いた回路構成となる。

【0052】

なお、発振回路の一部をインピーダンス変化する素子で構成し、発振周波数の

変化を検出する磁気検知方法が提案（例えば、特開平9-801347号公報）されているが、これは、発振周波数の変化を検出するものであり、発振の有無を検知する本発明とは原理が全く異なるものである。

【0053】

以上、本発明の実施の形態を説明してきたが、本発明は実施の形態に記載された構成・条件に限られるものではなく、各種の変更が可能である。

例えば、上記の実施の形態においては、再生ヘッドに用いる磁気センサを前提に説明しているが、再生ヘッド用の磁気センサに限られるものではなく、眠気センサ、タッチセンサ、水位センサ、ごみ処理分別センサ、或いは、防犯センサ等に利用される各種の磁気センサに応用できるものである。

【0054】

また、上記の実施の形態においては、磁気抵抗効果素子として、FeCo/AI-oxide/NiFe構造のTMR素子を用いているが、フリー層とピンド層の組合せは任意であり、保磁力の差を利用すれば良い。

【0055】

さらには、ピンド層のピン止めは、保磁力の差を利用せずにIrMnやPdPtMn等の反強磁性層を用いてピン止めしても良いものであり、それによって、ピンド層のピン止めが安定化するとともに、ピンド層とフリー層と同じ材料で構成することが可能になる。

【0056】

また、図2に示した回路における各構成要素の数値は、単なる一例であることは言うまでもなく、磁気ディスクにおける記録密度に応じてLC発振回路の発振周波数や、パルス入力V_{IN}の周波数を適宜設定すれば良いものである。

トランジスタ、抵抗、コンデンサ等はディスクリート部品ではなく、ICやLSIのように基板上に集積して用いても良いことはもちろんである。

【0057】

また、磁気抵抗効果素子として、特に効果が大きいTMR素子を用いているが、TMR素子に限られるものではなく、GMR素子或いはMR素子でも良いものであり、少なくとも外部磁場によりインピーダンスが変化するものであれば良い

が、特に、インピーダンスの実部だけではなく、TMR素子のように虚部も変化する容量性の素子であることがノイズの点から望ましい。

【0058】

【発明の効果】

本発明によれば、外部磁場によってインピーダンスの変化する磁気抵抗効果素子を発振回路との帰還ループ内に組み込んでいるので、従来の数十倍の安定した出力を得ることができ、次世代の再生用高感度磁気ヘッドの実現に寄与するところが大きい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の原理的構成の説明図である。

【図2】

本発明の第1の実施の形態の高感度磁気検知回路の回路構成図である。

【図3】

本発明の第1の実施の形態における発振出力結果の説明図である。

【図4】

本発明の第2の実施の形態の高感度磁気検知回路の回路構成図である。

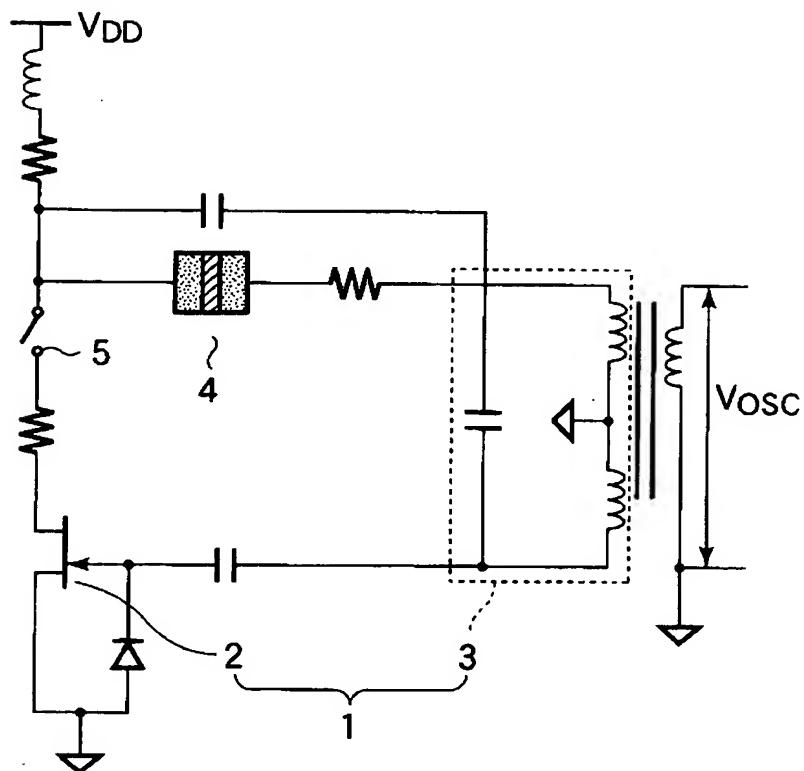
【符号の説明】

- 1 発振回路
- 2 トランジスタ
- 3 LC回路
- 4 磁気抵抗効果素子
- 5 スイッチング手段
- 10 ハートレー型発振回路
- 11 インダクタ
- 12 抵抗器
- 13 インダクタ
- 14 インダクタ
- 15 コンデンサ

- 16 テランジスタ
- 17 コンデンサ
- 18 抵抗器
- 19 ダイオード
- 20 TMR素子
- 21 抵抗器
- 22 コンデンサ
- 23 インダクタ
- 24 直流変換回路
- 25 端子
- 30 RFスイッチング回路
- 31 高周波用トランジスタ
- 32 パルス発生器
- 33 コンデンサ
- 34 ダイオード
- 35 抵抗器
- 36 抵抗器
- 40 コルピツ型発振回路
- 41 インダクタ
- 42 コンデンサ
- 43 コンデンサ

【書類名】 図面
【図 1】

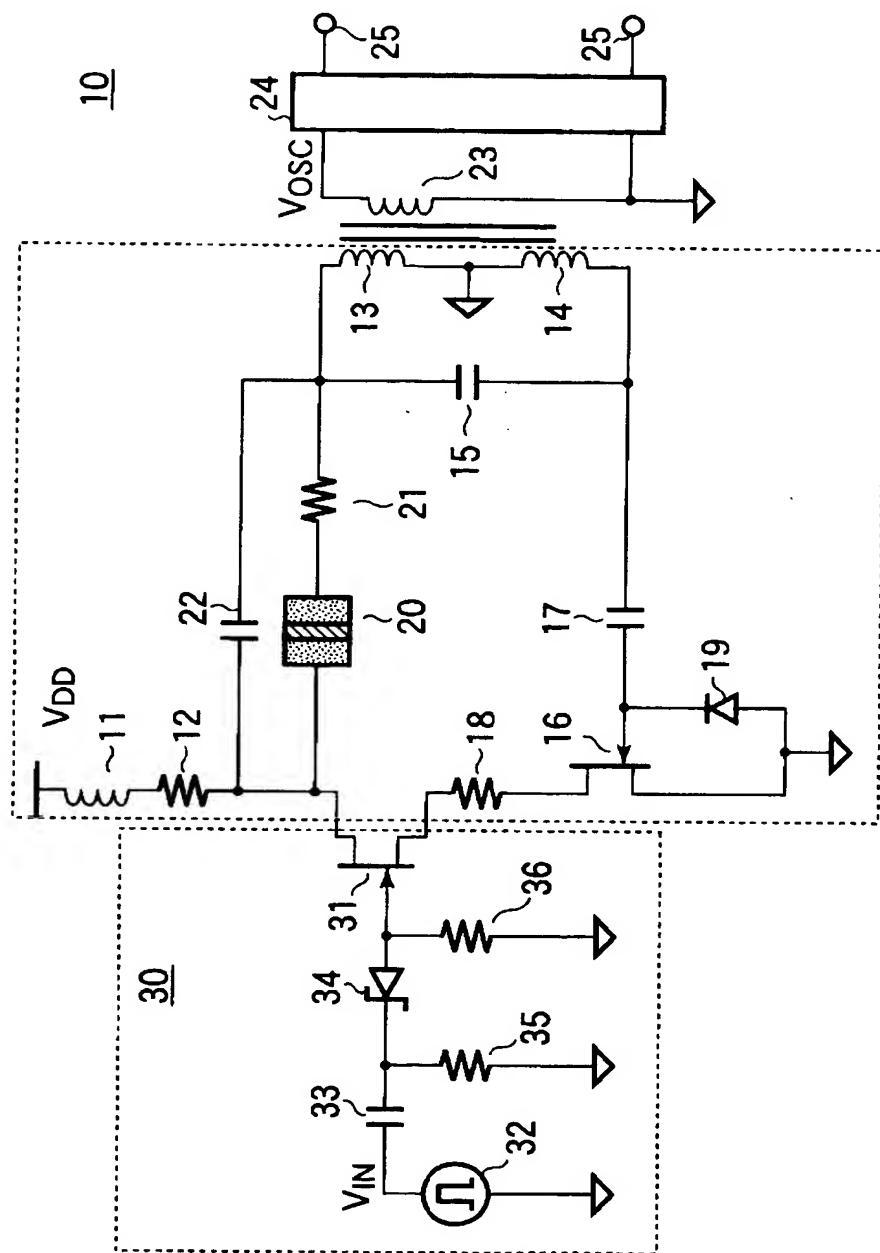
本発明の原理的構成の説明図



1：発振回路 4：磁気抵抗効果素子
2：トランジスタ 5：スイッチング手段
3：LC回路

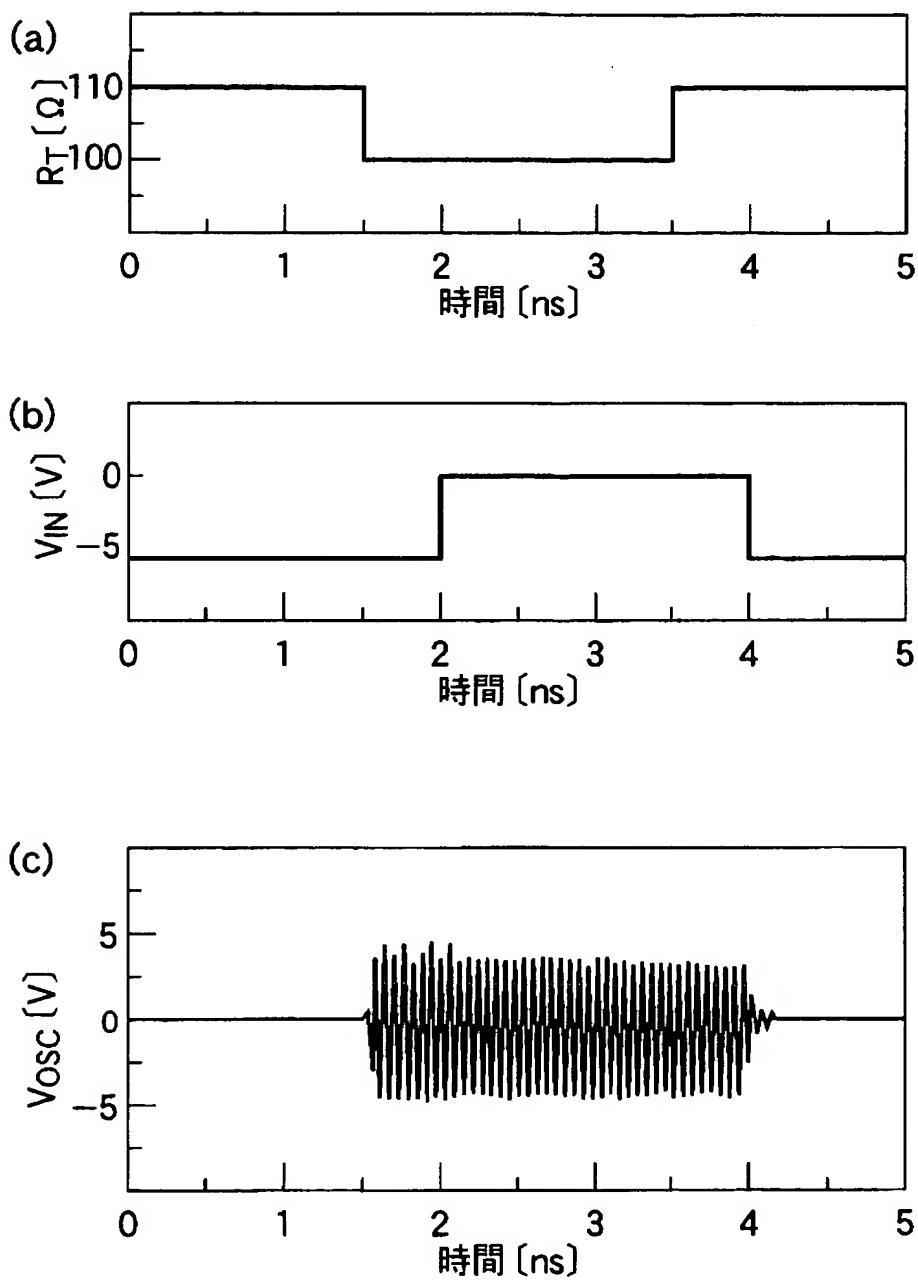
【図 2】

本発明の第1の実施の形態の高感度磁気検知装置の回路構成図



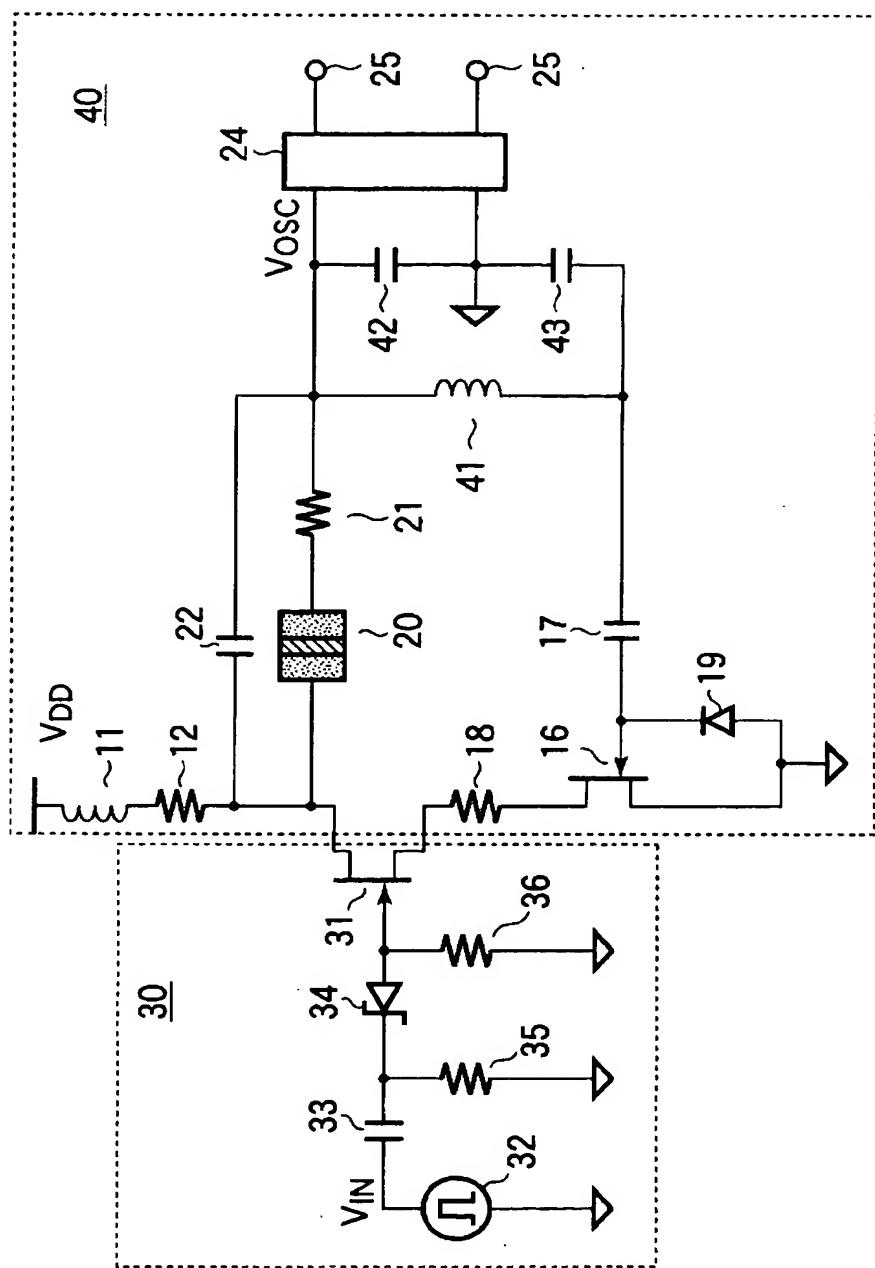
【図3】

本発明の第1の実施の形態の発振出力結果の説明図



【図4】

本発明の第2の実施の形態の高感度磁気検知装置の回路構成図



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 磁気抵抗効果を用いた磁気センサ、磁気抵抗効果を用いた磁気センサの駆動方法、及び、磁気記録装置に関し、流し得るセンス電流の上限による高感度化の制約を打破する。

【解決手段】 パソコン2及びLC回路3からなる発振回路1のトランジスタ2とLC回路3の帰還ループの一部に磁気抵抗効果素子4を接続するとともに、スイッチング手段5を設ける。

【選択図】 図1

特願 2003-118197

出願人履歴情報

識別番号 [899000079]

1. 変更年月日 1999年 9月17日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都港区三田2丁目15番45号

氏 名 学校法人慶應義塾